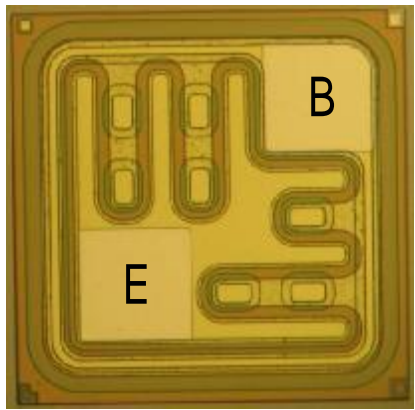


## 产品资料

## 几何参数

管芯尺寸 (MASK)	0.44 × 0.44 mm		
管芯厚度	210 ± 20 μm		
压焊区尺寸	基极	108 × 108 μm	
	发射极	110 × 110 μm	
正面金属层	Al		
背面金属层	Au		
圆片尺寸	Φ 125 mm		
每片有效管芯数	55,000		

## 极限值 (绝对最大额定值) (Ta=25℃) TO-92

参数	符号	规格	单位
集电极-基极电压	V <sub>CBO</sub>	-40	V
集电极电流	I <sub>C</sub>	-500	mA
集电极功耗	P <sub>C</sub>	625	mW
结温	T <sub>j</sub>	150	℃

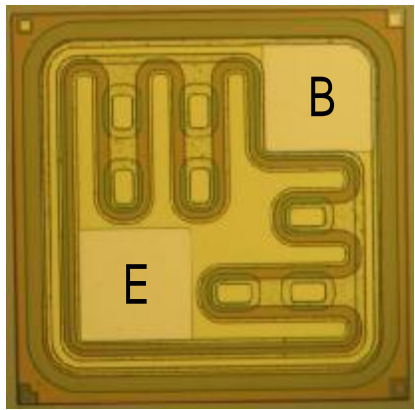
## 电特性 (Ta=25℃)

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
集电极-基极击穿电压	BV <sub>CBO</sub>	I <sub>C</sub> =-0.05mA, I <sub>E</sub> =0	-40			V
集电极-发射极击穿电压	BV <sub>CEO</sub>	I <sub>C</sub> =-1mA, I <sub>B</sub> =0	-20			V
发射极-基极击穿电压	BV <sub>EBO</sub>	I <sub>E</sub> =-0.05mA, I <sub>C</sub> =0	-5			V
集电极-基极截止电流	I <sub>CBO</sub>	V <sub>CB</sub> =-35V, I <sub>E</sub> =0			-0.1	μA
发射极-基极截止电流	I <sub>EBO</sub>	V <sub>EB</sub> =-5V, I <sub>C</sub> =0			-0.1	μA
直流电流增益	h <sub>FE</sub>	V <sub>CE</sub> =-1V, I <sub>C</sub> =-50mA	85		400	
集电极-发射极饱和电压	V <sub>CE(sat)</sub>	I <sub>C</sub> =-500mA, I <sub>B</sub> =-50mA			-0.6	V
基极-发射极饱和电压	V <sub>BE(sat)</sub>	I <sub>C</sub> =-500mA, I <sub>B</sub> =-50mA			-1.2	V
特征频率	f <sub>T</sub>	V <sub>CE</sub> =-6V, I <sub>C</sub> =-20mA f=30MHz	150			MHz



## 产品资料

## 几何参数

管芯尺寸 (MASK)	0.44 × 0.44 mm		
管芯厚度	210 ± 20 μm		
压焊区尺寸	基极	108 × 108 μm	
	发射极	110 × 110 μm	
正面金属层	Al		
背面金属层	Au		
圆片尺寸	Φ 125 mm		
每片有效管芯数	55,000		

## 极限值 (绝对最大额定值) (Ta=25℃) TO-92

参数	符号	规格	单位
集电极-基极电压	V <sub>CBO</sub>	-40	V
集电极电流	I <sub>C</sub>	-500	mA
集电极功耗	P <sub>C</sub>	625	mW
结温	T <sub>j</sub>	150	℃

## 电特性 (Ta=25℃)

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
集电极-基极击穿电压	BV <sub>CBO</sub>	I <sub>C</sub> =-0.05mA, I <sub>E</sub> =0	-40			V
集电极-发射极击穿电压	BV <sub>CEO</sub>	I <sub>C</sub> =-1mA, I <sub>B</sub> =0	-20			V
发射极-基极击穿电压	BV <sub>EBO</sub>	I <sub>E</sub> =-0.05mA, I <sub>C</sub> =0	-5			V
集电极-基极截止电流	I <sub>CBO</sub>	V <sub>CB</sub> =-35V, I <sub>E</sub> =0			-0.1	μA
发射极-基极截止电流	I <sub>EBO</sub>	V <sub>EB</sub> =-5V, I <sub>C</sub> =0			-0.1	μA
直流电流增益	h <sub>FE</sub>	V <sub>CE</sub> =-1V, I <sub>C</sub> =-50mA	85		400	
集电极-发射极饱和电压	V <sub>CE(sat)</sub>	I <sub>C</sub> =-500mA, I <sub>B</sub> =-50mA			-0.6	V
基极-发射极饱和电压	V <sub>BE(sat)</sub>	I <sub>C</sub> =-500mA, I <sub>B</sub> =-50mA			-1.2	V
特征频率	f <sub>T</sub>	V <sub>CE</sub> =-6V, I <sub>C</sub> =-20mA f=30MHz	150			MHz

